

PECプロセス装置



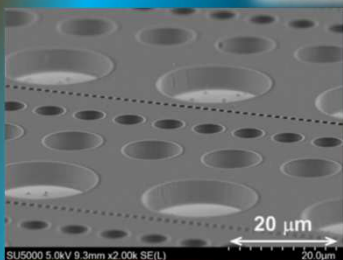
チラシ・動画は
こちらから



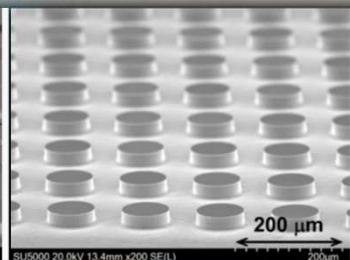
小片チップ, Φ 2in, 4in, 6in 対応

GaN 低ダメージエッチング

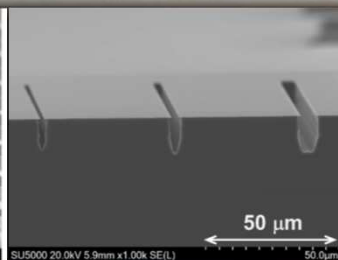
自動ウェットプロセス



深さ約7.7 μ m



深さ約7.7 μ m



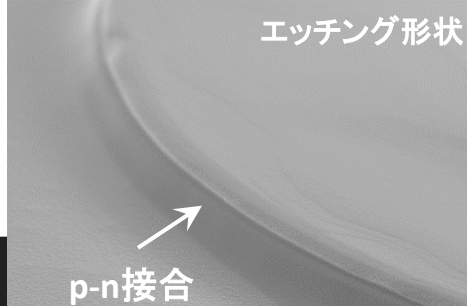
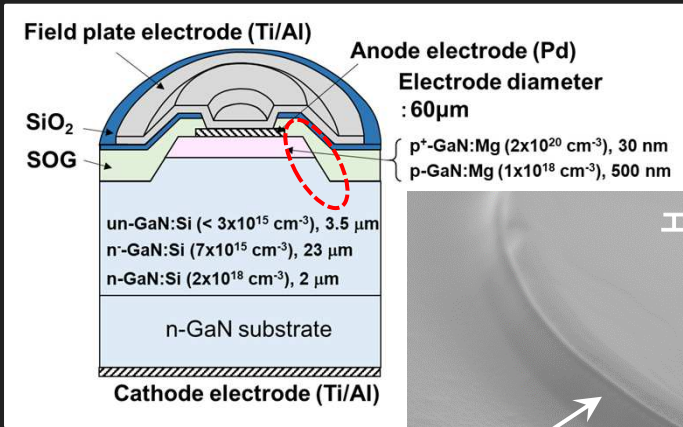
深さ約12~15 μ m



SU5000 5.0kV 15.3mm x110 SE(L)

株式会社 サイオクス様、
法政大学 マイクロナノテクノロジー
研究センター様 ご協力

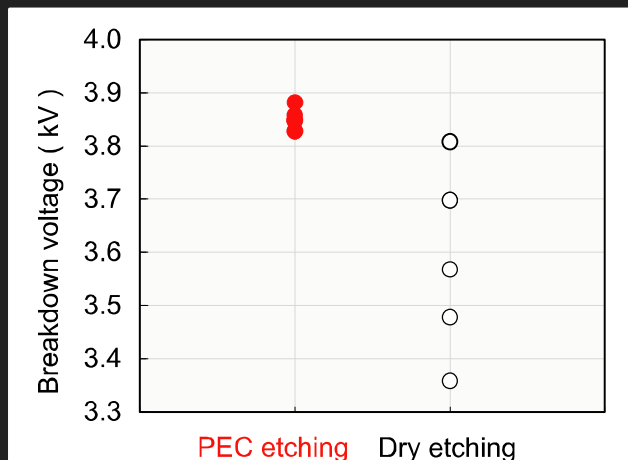
GaNウェハ低ダメージエッチング装置



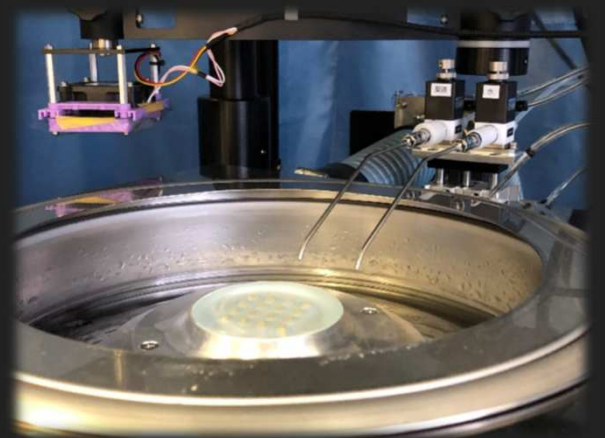
光源 波長
UVA UVC選択可能

加熱機能
エッチング溶液加熱により
高速な深堀エッチング可能

自動運転
タッチパネル入力でエッチング
リンスをパラメータ設定



PNダイオードの逆方向耐圧



高速ホットスピユニット



パラメータ設定画面

特徴

- ◆ 10mm□小片チップからφ6インチウェハ
- ◆ GaN 低ダメージエッチングが可能
- ◆ シンプル構造で低価格を実現

仕様	
型式	PEC-6
エッチング方式	Photo-Electro Chemical:光電気化学
適応ワーク	□10mm小片チップ、φ2~6インチ
UVA光源	超高圧水銀灯 315~400nm 15mW/sm ² 以上
UVC光源	プラズマ光源 220~320nm 12mW/sm ² 以上
薬液供給	2ノズルエア圧縮方式 エッチング液、リンス液
外形寸法	1470(H) × 650(W) × 750(D)